

Germanium-Hochfrequenz-Transistoren bis zu 260 MHz

Type	Kennwerte bei $\vartheta_a = 25^\circ \text{C} - 5 \text{ grad}$							Höchstwerte			Bauform	Verwendungszweck
	Steilheit in Emitterschaltung			Basisbahnwiderst. $r_{Bb}$ [ $\Omega$ ]	Grenzfrequenz		Koll.-reststrom (-I <sub>CBO</sub> ) [ $\mu\text{A}$ ]	Koll.-strom -I <sub>C</sub> [mA]	Wärme-widerstand $R_{th}$ [ $\frac{\text{grad}}{\text{mW}}$ ]	Sperrschicht-temp. $\vartheta_j$ [ $^\circ\text{C}$ ]		
	[ $Y_{21b}$ ], $Y_{21e} \frac{\text{mA}}{\text{V}}$ bei:				$f_{h21b}$ [MHz]	$f_1$ (f <sub>T</sub> ) [MHz]						
	-U <sub>CE</sub> = 6 V -I <sub>C</sub> = 0,5 mA f = 500 kHz	-U <sub>CE</sub> = 6 V -I <sub>C</sub> = 0,5 mA f = 2 MHz	-U <sub>CE</sub> = 6 V -I <sub>C</sub> = 1 mA f = 10 MHz [f = 100 MHz]		-U <sub>CE</sub> = 6 V -I <sub>C</sub> = 0,5 mA	-U <sub>CE</sub> = 6 V -I <sub>C</sub> = 1 mA						
GF 100	> 13	—	—	< 300	> 3	—	< 800	15	< 1	75	17	ZF-Stufen bis 470 KHz
GF 105	—	> 10	—	< 350	> 7	—	< 800	15	< 1	75	17	Mischstufen bis 2 MHz
GF 120	—	> 10	—	< 300	—	> 10	< 500	10	0,6	75	18	Mischstufen bis 3 MHz
GF 121	—	—	> 22	< 200	—	> 25	< 500	10	0,6	75	18	Vor- und Mischstufen im KW-Bereich
GF 122	—	—	> 28	< 100	—	> 30	< 500	10	0,6	75	18	ZF-Stufen bis 10,7 MHz
GF 125*)	—	—	> 30	< 100	—	> 30	< 500	10	0,6	75	18	
GF 129	—	> 10	—	—	—	(75)	(7,5)	10	> 1	75	19	Vor- und Mischstufen MW und LW
GF 130	—	—	> 28	—	—	(75)	(7,5)	10	> 1	75	19	ZF-Transistor bis 10,7 MHz
GF 131	—	—	[11 mS]	—	—	(85)	(7,5)	10	> 1	75	19	UKW-Mischtransistor
GF 132	—	—	[14 mS]	—	—	(85)	(7,5)	10	> 1	75	19	UKW-Vorstufen
GF 140*)	—	—	> 10	—	—	(300)	< 100	70	$P_C = 180 \text{ mW}$	100	20	
GF 141*)	—	—	> 10	—	—	(300)	< 100	70	180 mW	100	20	HF-Verstärker, HF-Kleinleistungsstufen, Misch- und Oszillatorstufen bis zu 260 MHz
GF 142*)	—	—	> 10	—	—	(300)	< 100	70	180 mW	100	20	
GF 143*)	—	—	> 10	—	—	(300)	< 100	70	180 mW	100	20	

Silizium-Transistoren für hochwertige NF-Verstärker- und Schalteranwendungen

Type	Kennwerte bei $\vartheta_a = 25^\circ \text{C}$			Höchstwerte					Bauform	Verwendungszweck
	Stromverstärkung $h_{21e}$ [B]	Rauschmaß F [dB]	Grenzfrequenz $f_1$ (f <sub>T</sub> ) [MHz]	Kollektorspannung -U <sub>CE</sub> [V]	Emitterspannung U <sub>BE</sub> [V]	Kollektorstrom -I <sub>C</sub> [mA]	Verlustleistung P <sub>C</sub> [mW]	Sperrschichttemperatur $\vartheta_j$ [ $^\circ\text{C}$ ]		
SC 100	8...20	$\leq 6$ 15	$\geq 0,8$	10	10	50	250	150	21	NF-Transistor
SC 103	20...30	$\leq 6$ 15	$\geq 1,5$	10	10	50	250	150		NF-Transistor
SC 104	30...50	$\leq 6$ 15	$\geq 3$	10	10	50	250	150		NF-Transistor
SS 101	8...25	$\leq 6$ 15	$\geq 0,6$	33	33	50	250	150		Schalttransistor
SS 102	8...25	$\leq 6$ 15	$\geq 0,3$	66	33	50	250	150		Schalttransistor
SF 111*)	> (12)	—	(40)	20	—	200	400	150	21	Transistoren mittlerer Leistung für Hochfrequenzverstärkung und für Schaltzwecke
SF 112*)	> (12)	—	(40)	30	—	200	400	150		
SF 113*)	> (12)	—	(40)	60	—	200	400	150		
SF 114*)	> (12)	—	(40)	100	—	200	400	150		
SL 112*)	> (12)	—	(40)	30	—	400	$R_{thi} [\frac{\text{grad}}{\text{W}}]$ 15	150	15	HF-Leistungstransistor und Schalttransistor für höhere Batteriespannungen u. Umgebungstemperaturen
SL 113*)	> (12)	—	(40)	60	—	400	15	150		
SL 114*)	> (12)	—	(40)	100	—	400	15	150		

\*) in Entwicklung